

20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

VDS= -20V

RDS(ON), Vgs@-4.5V, Ids@-2.8A < 130mΩ

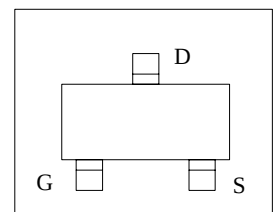
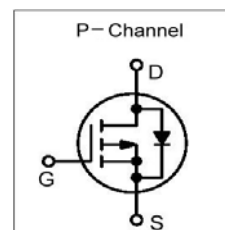
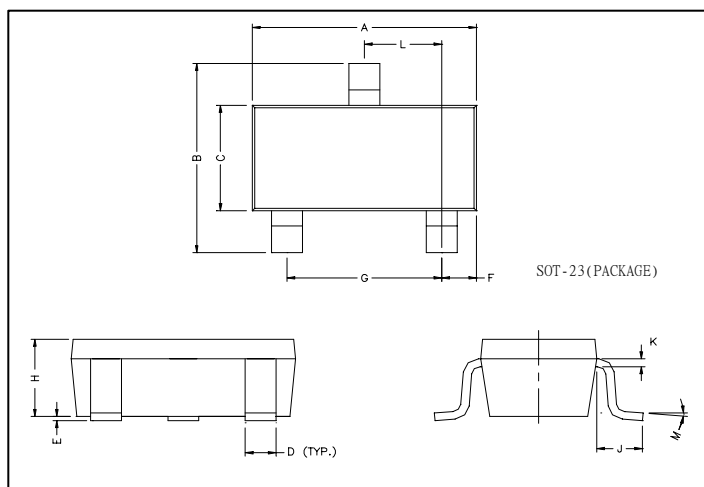
RDS(ON), Vgs@-2.5V, Ids@-2.0A < 190mΩ

Features

Advanced trench process technology

High Density Cell Design For Ultra Low On-Resistance

Package Dimensions



REF.	Millimeter		REF.	Millimeter	
	Min.	Max.		Min.	Max.
A	2.70	3.10	G	1.90	REF.
B	2.40	2.80	H	1.00	1.30
C	1.40	1.60	K	0.10	0.20
D	0.35	0.50	J	0.40	-
E	0	0.10	L	0.85	1.15
F	0.45	0.55	M	0°	10°

Maximum Ratings and Thermal Characteristics (TA = 25°C unless otherwise noted)

Parameter		Symbol	Limit	Unit
Drain-Source Voltage		V _{DS}	-20	V
Gate-Source Voltage		V _{GS}	±8	
Continuous Drain Current		I _D	-2.2	A
Pulsed Drain Current ¹⁾		I _{DM}	-8	
Maximum Power Dissipation ²⁾	TA = 25°	P _D	1.25	W
	TA = 75°C		0.8	
Operating Junction and Storage Temperature Range		T _J , T _{stg}	-55 to 150	°C
Junction-to-Ambient Thermal Resistance (PCB mounted) ²⁾		R _{thJA}	100	
Junction-to-Ambient Thermal Resistance (PCB mounted) ³⁾			166	

Notes

- ¹⁾ Pulse width limited by maximum junction temperature.
- ²⁾ Surface Mounted on FR4 Board, t ≤ 5 sec.
- ³⁾ Surface Mounted on FR4 Board.



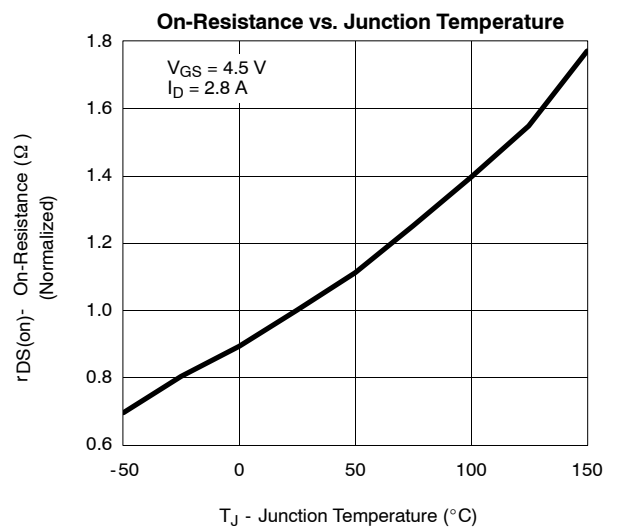
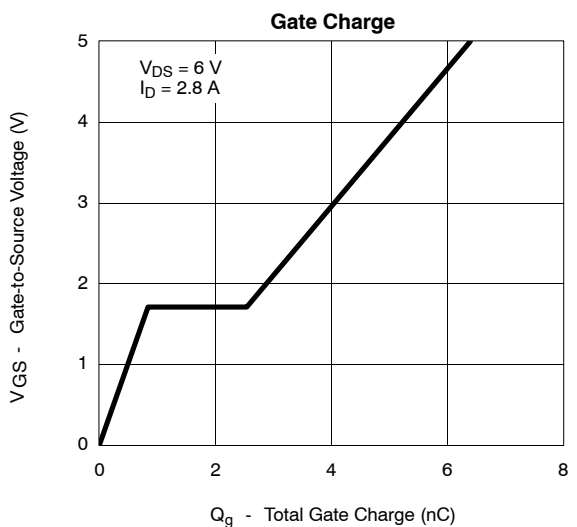
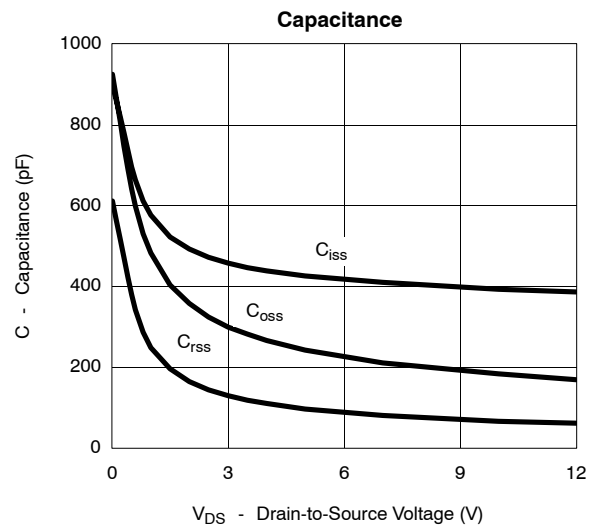
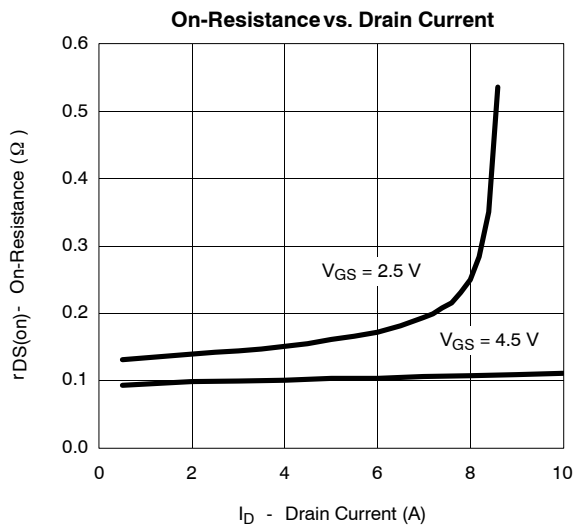
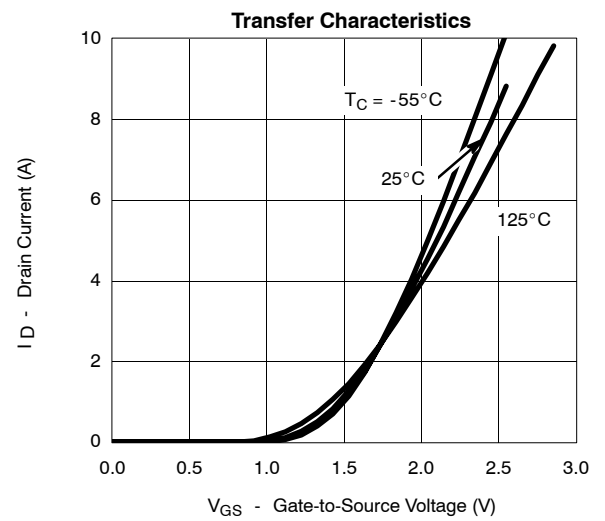
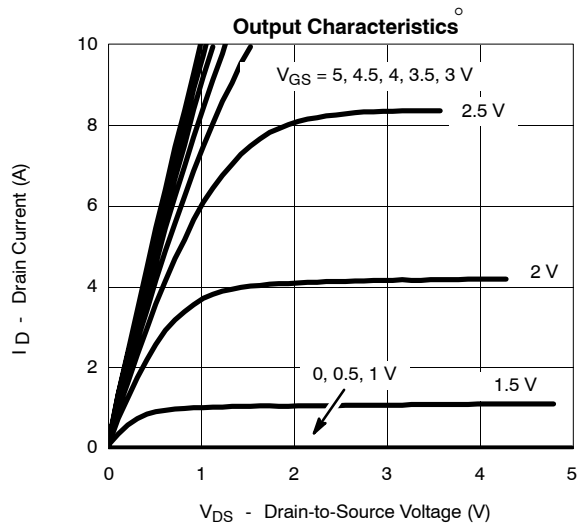
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

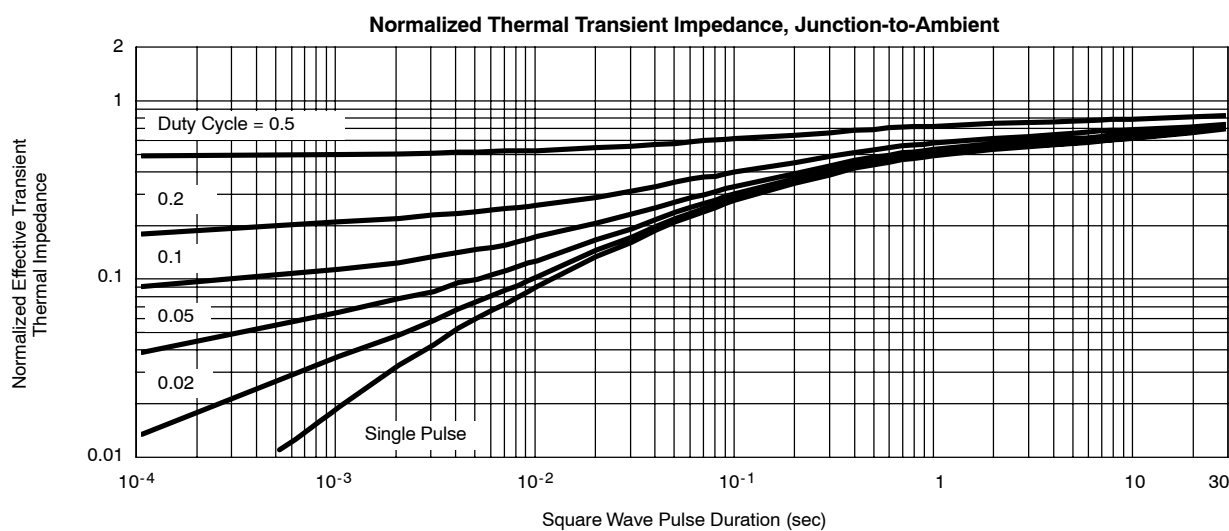
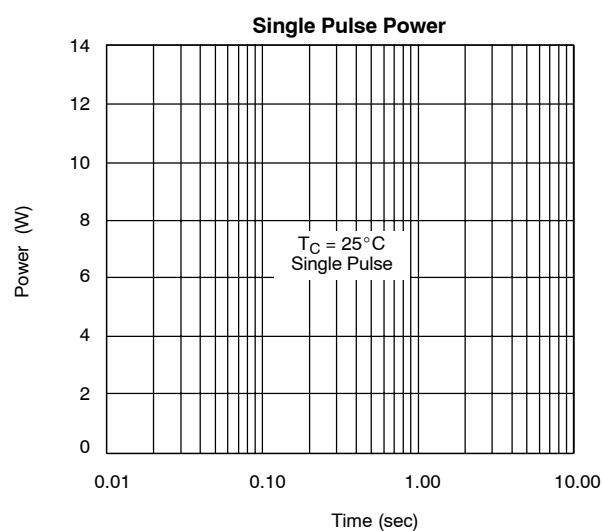
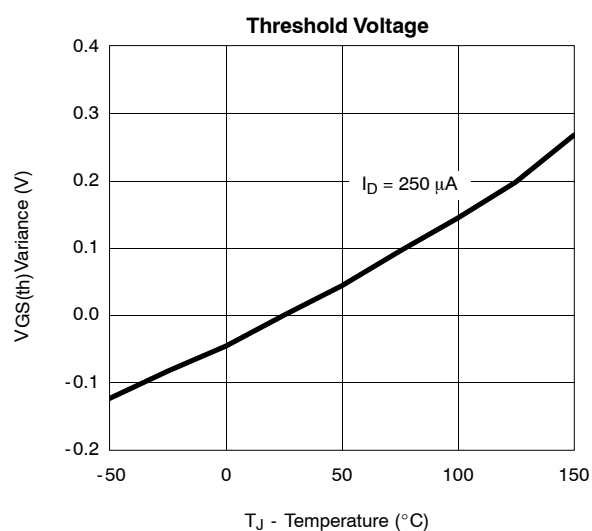
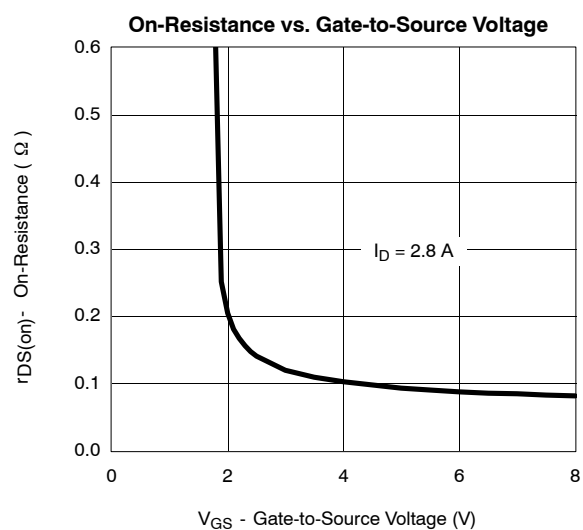
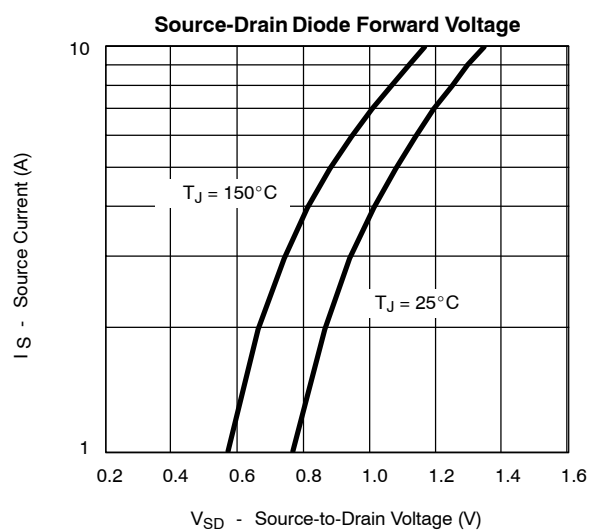
Parameter	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Static						
Drain-Source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	V _{GS} = 0V, I _D = -250uA	-20			V
Drain-Source On-State Resistance ¹⁾	R _{DS(on)}	V _{GS} = -4.5V, I _D = -2.8A		105	130	mΩ
		V _{GS} = -2.5V, I _D = -2.0A		145	190	
Gate Threshold Voltage	V _{GS(th)}	V _{DS} =V _{GS} , I _D = -250uA	-0.45			V
Zero Gate Voltage Drain Current 0	I _{DSS}	V _{DS} = -20V, V _{GS} = 0V			-1	uA
		V _{DS} = -20V, V _{GS} = 0V TJ=55 ⁰ C			-10	
Gate Body Leakage	I _{GSS}	V _{GS} = ± 8V, V _{DS} = 0V			±100	nA
Forward Transconductance ¹⁾	g _{fs}	V _{DS} = -5V, I _D = -2.8A		6.5	—	S
Dynamic						
Total Gate Charge	Q _g	V _{DS} = -6V, I _D ≅ -2.8A V _{GS} = -4.5V		5.8	10	nC
Gate-Source Charge	Q _{gs}			0.85		
Gate-Drain Charge	Q _{gd}			1.7		
Turn-On Delay Time	t _{d(on)}	V _{DD} = -6V, RL=6Ω I _D ≅ -1.A, V _{GEN} = -4.5V R _G = 6Ω		13	25	ns
Turn-On Rise Time	t _r			36	60	
Turn-Off Delay Time	t _{d(off)}			42	70	
Turn-Off Fall Time	t _f			34	60	
Input Capacitance	C _{iss}	V _{DS} = -6V, V _{GS} = 0V f = 1.0 MHz		415		pF
Output Capacitance	C _{OSS}			223		
Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}			87		
Source-Drain Diode						
Max. Diode Forward Current	I _S				-1.6	A
Diode Forward Voltage	V _{SD}	I _S = -1.6A, V _{GS} = 0V		-0.8	-1.2	V

¹⁾ Pulse test: pulse width $\leq 300\mu s$, duty cycle $\leq 2\%$

20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET



20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.